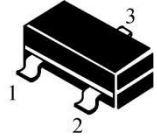


2SC2412

SOT-23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■ FEATURES 特點

NPN General Purpose Transistor

■ MAXIMUM RATINGS (T_a=25°C) 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V _{CBO}	60	V
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V _{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V _{EBO}	7	V
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I _c	150	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P _C	225	mW
Junction Temperature 結溫	T _j	150	°C
Storage Temperature Range 儲存溫度	T _{stg}	-55~150	°C

■ DEVICE MARKING 打標

2SC2412	Q	R	S
MARK	BQ	BR	BS
H _{FE}	120~270	180~390	270~560

2SC2412 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

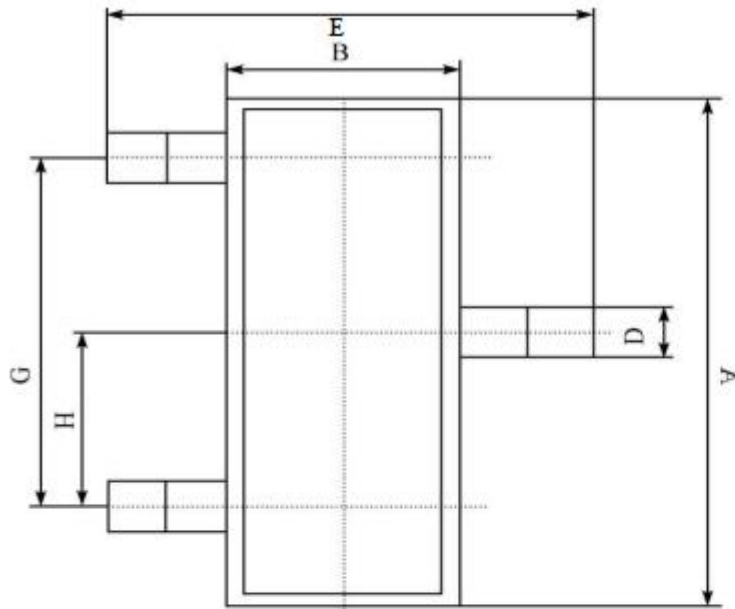
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60\text{V},$ $I_E=0$	—	—	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=7\text{V},$ $I_C=0$	—	—	0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=50\mu\text{A}$	60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50\mu\text{A}$	7	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE}	$V_{CE}=6\text{V},$ $I_C=1\text{mA}$	120	—	560	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=50\text{mA},$ $I_B=5\text{mA}$	—	—	0.4	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=100\text{mA},$ $I_B=10\text{mA}$	—	—	1.0	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=12\text{V},$ $I_C=2\text{mA},$ $f=100\text{MHz}$	—	180	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=12\text{V},$ $I_E=0\text{A},$ $f=1\text{MHz}$	—	2.0	3.5	pF

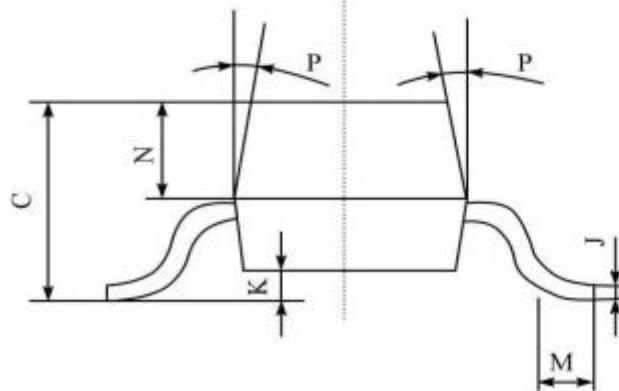
2SC2412

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°





安徽富信半導體科技有限公司
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

2SC2412